

СОДЕРЖАНИЕ

Материалы X Российского симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твёрдых тел (РЭМ-97)

Соколов В.Н., Юрковец Д.И., Разгулина О.В., Мельник В.Н. Использование фурье-анализа РЭМ-изображений для получения морфологических характеристик микроструктуры	450
Юдина Л.А., Фролов А.М., Чухрий Н.И., Юдин В.В. Системная методика обработки сложных РЭМ-изображений	455
Панин Г.Н., Диаз-Гэрра К., Пикэрас Х. Исследование заряженных дефектов в CdTe и CdHgTe методами сканирующей электронной и туннельной микроскопии	461
Комолова Л.Ф., Самуйлова Е.Н., Разумовская И.В., Шевцова Н.Ф. Особенности локальной активации катодолюминесценции в тонких пленках оксидов	467
Говорков А.В., Поляков А.Я., Смирнов Н.Б., Редвинг Дж.М., Скворонский М., Шин М. Исследование в РЭМ неоднородностей и дефектов в эпитаксиальных слоях GaN и AlGaN	471
Киреев В.А., Разгонов И.И. Латеральное распределение сигнала модуляционной катодолюминесценции в пространственно неоднородных образцах с большой диффузионной длиной	477
Пахомова И.Ю., Суворинов А.В., Филипчук Т.С., Шахбазов С.Ю. Влияние условий торможения на яркость пучка в низковольтных электронно-лучевых приборах высокого разрешения	486
Степина Н.Д., Толстихина А.Л., Клечковская В.В., Беляев В.В., Фейгин Л.А., Хрипунов А.К., Лаврентьев В.К., Баклагин Ю.Г., Волков А.Я. Структура пленок Ленгмюра – Блоджетт на основе ацетовалератов целлюлозы	492
Гончаренко Ю.Д., Евсеев Л.А. Применение растровой электронной микроскопии, оже-электронной спектроскопии, вторично-ионной масс-спектрометрии для обнаружения и исследования структуры и элементного состава электроизоляционного покрытия	496
Огнев А.Н., Васильева Н.Д., Дмитриев В.А. Исследование морфологии эпитаксиальных слоев титанового силленита	502
Николайчик В.И., Клишкова Л.А. Аналитическая электронная микроскопия металл-оксидных материалов системы Ba-Bi-O	510
Бешенков В.Г., Знаменский А.Г., Марченко В.А. Идентификация фаз в тонких пленках многокомпонентных оксидов по оже-спектрам при ионном профилировании	517
Панин Г.Н., Валяев В.В., Гуртовой В.Л., Парахонский А.Л. Исследование электрической неоднородности пленок GaAs и AlGaAs, выращенных методом MOSVD	523
Березкин В.В., Буряков А.Н., Загорский Д.Л., Нечаев А.Н., Цыганова Т.В., Мчедlishvili Б.В. Исследование структурно-селективных свойств трековых мембран методом растровой электронной микроскопии	528
Машкова Л.П. Изучение структуры, морфологии и удельной поверхности пористых тел по их электронно-микроскопическим изображениям	534
Ашерн А., Терра Ф.С., Эль-Шазли А.А. Приготовление n-(GaAl)Al/p-GaAs солнечных батарей методом жидкофазной эпитаксии и их характеристики	539
Новиков Ю.А., Раков А.В., Филиппов М.Н. Линейные измерения в РЭМ элементов с трапециевидным профилем при разных энергиях электронов зонда	543
Бестаев М.В., Димитров Д.Ц., Ильин А.Ю., Крюков И.И., Мошников В.А., Трэгер Ф., Штиц Ф. Атомно-силовая микроскопия слоев диоксида олова для газовых сенсоров	549
Мошников В.А., Румянцева А.И., Рыбников А.И. Рентгеноспектральный микроанализ высокоомных образцов	552
Голиков Ю.К., Кольцов С.Н., Холин Н.А. Разработка высокоразрешающего светосильного анализатора на основе электростатического цилиндрического аксиально-неоднородного поля	555
Крюков И.И., Мошников А.В., Рыбников А.И. Разработка методик количественного рентгеноспектрального микроанализа многокомпонентных материалов	559
Батов Д.В., Елютин А.В., Иванов Л.С., Петров В.И., Степович М.А., Филиппов М.Н. Экологически безопасная технология производства и электронно-микроскопическое исследование структуры и состава толстопленочного SiC	565
Ланин С.В., Петров В.И., Степанов С.Е., Степович М.А. Оптимизация методов обработки спектров катодолюминесценции полупроводников с использованием LULU- и сплайн-сглаживания	570
Астахов В.П., Карпов В.В., Пибалк А.В., Степович М.А., Терра Ф.С. Изучение локальных свойств и электрофизических характеристик фотодиодов на основе монокристаллического InSb с различными защитными покрытиями	578
	669

Булярский С.В., Лукьянов А.Е., Светухина О.С., Ионычев В.К., Колмыков Д.В. Рекомбинационная способность дислокаций в карбиде кремния	587
Гостев А.В., Матвиенко А.Н., Рау Э.И., Савин В.О., Савин Д.О. К вопросу об информационной глубине режима обратноотраженных электронов в РЭМ	591
Гостев А.В., Жуков А.Н., Молл Ш.Х., Рау Э.И., Якимов Е.Б. Анализ информации, получаемой методом электронно-индуцированной ЭДС в РЭМ	599
Васичев Б.Н., Зотова М.О. Влияние погрешностей распределения осевого магнитного поля на результаты расчета и моделирования магнитных электронных линз	606
Трофимов В.А., Филипчук Т.С. Пространственная структура полей квадрупольных электростатических линз с криволинейными вырезами в электродах	610
Гелевер В.Д., Птицын В.Э., Галль Л.Н., Жуков В.А. О возможности создания на базе термополевых катодов низкоэнергетических субмикронных электронных зондов с высокой плотностью мощности и о перспективах использования таких зондов	615
Злобин В.А. Развитие стратегии электронной литографии для интегральных полупроводниковых приборов большой мощности	622
Куприянова Т.А., Филиппов М.Н. Определение легких элементов в электронно-зондовом микроанализе	627
Коханчик Л.С., Якимов Е.Б. Влияние температуры на сигнал вторичной электронной эмиссии в пироэлектрике LiNbO_3	635
Обыден С.К., Иванников П.В., Сапарин Г.В. Получение изображений рельефных объектов в растровом электронном микроскопе в режиме цветной катодолюминесценции	641
Тимофеюк Н.К., Турсунмуратов Т.М., Ярмухамедов Р. Расчет ядерных вершинных констант виртуальных распадов ${}^7\text{Li} \rightarrow \alpha + t$ и ${}^7\text{Be} \rightarrow \alpha + {}^3\text{He}$ в α -кластерной потенциальной модели и их сравнительный анализ*	650
Бережной Ю.А., Корда В.Ю. Интегральные сечения дифракционного взаимодействия ядер ${}^3\text{H}$ и ${}^3\text{He}$ с тяжелыми ядрами*	654
Евланов М.В., Соколов А.М., Тартаковский В.К. Интегральные сечения взаимодействия гипертрионов высокой энергии с ядрами*	665

* Статьи доложены на XLVI Международном совещании по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра.